

PAT-NO: JP359088863A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 59088863 A

TITLE: SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: May 22, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIRAGASAWA, TSUYOSHI

KONDO, SHUJI

INT-CL (IPC): H01L023/48, H01L025/00

US-CL-CURRENT: 257/686, 257/723 , 257/E25.011

ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive to make composite-multifunctional and speed up by a method wherein a desired electrode is directly connected by opposing the main surface of another LSI substrate to one LSI substrate, which are fixed to each other.

CONSTITUTION: Functional elements are integrated on the main surface of the substrate 1 and covered with a protection film 2, a part of the film 2 is removed, and a bump electrode 3 is laid. Functional elements are integrated also on the main surface of the substrate 4, a protection film 5 and an electrode 6 are formed. The main surface of the substrate 4 is placed on the main surface of the substrate 1 in opposition thereto, and the solder plate electrodes 6 and 3 are heated and connected. If necessary, metallic lead wires 7 are connected simultaneously at the time of mutual connection of the electrodes. Epoxy resin 8 is applied on the side surface of the substrates and in gaps and solidified, resulting in adhesion. This constitution enables to make multifunctional to a high density by superposing LSI's without increasing the area of the substrate.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—88863

⑤ Int. Cl.³
H 01 L 23/48
25/00

識別記号

庁内整理番号
6819—5F
7638—5F

④ 公開 昭和59年(1984)5月22日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 半導体装置

① 特 願 昭57—199206

② 出 願 昭57(1982)11月12日

⑦ 発 明 者 白ヶ澤強

門真市大字門真1006番地松下電
器産業株式会社内

⑧ 発 明 者 近藤修司

門真市大字門真1006番地松下電
器産業株式会社内

⑩ 出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑪ 代 理 人 弁理士 中尾敏男 外 1 名

明 細 書

1、発明の名称

半導体装置

2、特許請求の範囲

機能素子と電極部を有する第1の半導体基板の
主面に、機能素子を集積化し電極部を有する他の
少くとも1個の第2の半導体基板の主面を対向
載置せしめ、前記第1と第2の基板の所望電極相
互を接続し、基板相互を固着せしめてなる半導体
装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体装置に関するものであり、特
に高密度多機能化半導体装置を提供するものであ
る。

従来例の構成とその問題点

システム機器の小形化、高速化の要求に伴い、
半導体集積回路(以降LSIと称する)高密度化、
多機能化をする事が望まれている。この為、LSI
パターンの微細化がはかられているが、微細化に

2

伴う種々の問題ある為、実用上は微細化には限界
がある。又、多機能化へのアプローチとしては高
集積化による大規模LSI化が行われている。一
方、多機能化する為に半導体プロセスの複合化も
一部に試みられているが実用化には至っていない。
即ち異種の半導体デバイスを同一基板上に形成す
る事は現在の技術では困難とされる。

この為、半導体装置を多機能化、高積化する為
に同種又は異種の半導体基板を高密度実装する技
術が提案され、一部に実施されている。

従来の一例を第1図をもとに説明する。

第1図に於いて、セラミック基板1の主面上に
は、配線パターン2及び外部電極3が設けてあり、
更にLSIチップ4の電極部と、同基板上配線パ
ターン2の一部とを接続する為の内部電極(図示
せず)が配置されている。LSIチップ4の電極
は、凸状をなす、いわゆる bumps 形式で形成され、
該 bumps と、前記内部電極とは直接に接続される
“フリップチップ”により接続される。

本構成によれば、同一基板上に複数の同種、又

発明の効果

本発明の半導体装置は、半導体基板相互を縦方向に接続する構造をなし、基板間電極相互を直接に接続する為、多機能半導体装置を高密度に実現でき、更に配線抵抗、配線容量を大幅に軽減できる為、高速動作を可能ならしめるものである。

又、本発明によれば、半導体基板主面上の能動領域が半導体装置表面又は裏面から深くなる為、 α 線によるソフトエラーも大幅に減少せしめることができる。

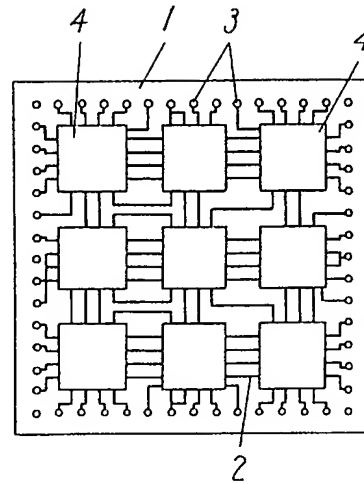
4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の半導体装置の構成を示す図、第2図、第3図、第4図はそれぞれ本発明の実施例における半導体装置の断面図である。

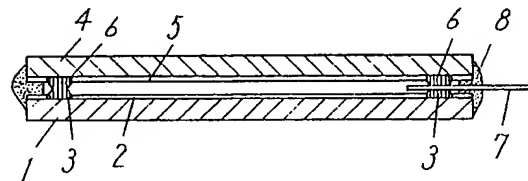
1, 4……半導体基板、3, 6……電極、7……リード線、8……エポキシ樹脂、9…… $\Lambda\theta$ 線。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

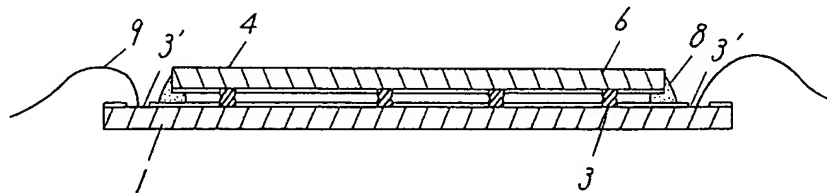
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図

